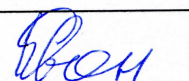


Сведения об официальном оппоненте

по диссертационной работе Есина Варнавы Денисовича на тему «Транспорт в топологических полуметаллах в нелинейном режиме: спиновый диод и нелинейный эффект Холла», представленной к защите на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.8 – Физика конденсированного состояния

ФИО	Квон Дмитрий Харитонович
Гражданство	РФ
Учёная степень	Доктор физико-математических наук
Специальность	01.04.10 – физика полупроводников
Учёное звание	Профессор, чл.-корр. РАН
Почтовый индекс, адрес, web-сайт, e-mail организации	630090, Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 13. https://www.sbras.ru/ru/organization/2244 , e-mail: kvon@isp.nsc.ru
Полное наименование организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук
Ведомственная принадлежность	Российская академия наук
Наименование подразделения	Лаборатория физики низкоразмерных электронных систем
Должность	Заведующий лабораторией
<p>Список основных публикаций оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. J. Gospodaric, V. Dziom, A. Shuvaev, A. A. Dobretsova, N. N. Mikhailov, Z. D. Kvon, and A. Pimenov "Superradiant and transport lifetimes of the cyclotron resonance in the topological insulator HgTe", Phys. Rev. B, v. B 99, 115130 (2019). 2. З.Д. Квон, Д.А. Козлов, Е.Б. Ольшанецкий, Г.М. Гусев, Н.Н. Михайлов, С.А. Дворецкий "Топологические изоляторы на основе HgTe", УФН 2020, Т.190, №7, С. 673-692. 3. З.Д. Квон, Е.Б. Ольшанецкий, М.А. Дрофа, Н.Н. Михайлов "Андерсоновская локализация в двумерной электронно-дырочной системе", Письма в ЖЭТФ, 2021, Т.114, №6, С. 377-382. 4. G. M. Gusev, Z. D. Kvon, D. A. Kozlov, E. B. Olshanetsky, M. V. Entin and N. N. Mikhailov "Transport through the network of topological channels in HgTe based quantum well", 2D Mater. 2022, v.9, С. 015021-1-8. 5. Z. D. Kvon "Semiconductor Quantum Wells and Nanostructures", Nanomaterials 2023, v.13, С. 1924-1-2. <p>...</p>	

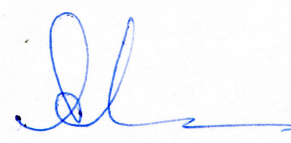
Квон Дмитрий Харитонович


подпись

«31» 10 2023 г.

Подпись Квона Д.Х. заверяю
Заместитель директора ИФП СО РАН
к.ф.-м.н. А. В. Каламейцев




подпись